

半导体学报

第7卷 第3期 1986年5月

目 录

- GaAs/GaAlAs pnpn 负阻激光器异质基区输运特性及载流子限制因子 张权生 吴荣汉 (227)
- 短栅 GaAs MESFET 中电子饱和速度 杨悦非 王渭源 (237)
- 用二次函数分段插值法计算扩展电阻修正因子 舒 畅 包宗明 (242)
- α -Al₂O₃-Si 界面电子结构的研究 沈 清 林理彬 (248)
- LPE n-GaAlAs:Te 中 DX 中心的导纳谱分析 葛惟锬 吴荣汉 (254)
- MOS 电容微分量的频率特性——确定 Si/SiO₂ 界面态密度分布及俘获截面的一种新方法 许铭真 谭长华 (264)
- 采用统计试验法分段优化提取双极型晶体管 GP 直流模型参数 张 力 夏武颖 (275)
- LSIS-II 布图设计系统中的联接关系正确性验证子系统 高春华 庄文君 (284)
- 有向和无向混合图通道布线算法 周 电 唐璞山 (292)
- 在多数载流子对边区作非饱和填充的条件下测量深中心分布的理论与实践 陈开茅 秦国刚 (298)

研究简报

- 电子辐照激活硅中不激活铜的 DLTS 测量方法 陈开茅 钱思敏 兰李桥 (308)
- GaAs、InP 阳极氧化薄膜的光电子能谱、俄歇电子能谱分析 周 勉 王渭源 (314)
- 200ps 脉冲激发的 MBE GaAs-Ga_{1-x}Al_xAs 多量子阱异质结的光致发光特性 徐仲英 许继宗 李玉璋 郑宝真 徐俊英 庄蔚华 陈宗圭 (319)
- 1.3 微米 InGaAsP/InP 双沟道平面掩埋异质结激光器 赵嵩山 王德超 吴友宇 王玉章 (324)
- 溅射 GaAs SOI 电子束退火再结晶及 MBE GaAs SOI 高频感应石墨棒热退火再结晶 朱蔚雯 王渭源 (327)

研究快报

- 两种新型的非晶半导体多层结构 陈治明 王建农 梅向阳 孔光临 (331)
- 中子辐照硅单晶中一组新的红外吸收峰 祁明维 施天生 白国仁 谢雷鸣 蔡培新 高集金 李石岭 (334)
- 1.3 微米低阈值大功率基横模 BH InGaAsP/InP 激光器 王 圩 张静媛 田慧良 汪孝杰等 (337)